



МИКРОСХЕМА КН ІВЗІ ВУІ

ЭТИКЕТКА

Микросхема КН ІВЗІ ВУІ предназначена для выполнения функций микропрограммного управления в микропроцессоре.

Конструктивно-технологическая группа XIII, исполнение 2.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫВОДОВ.

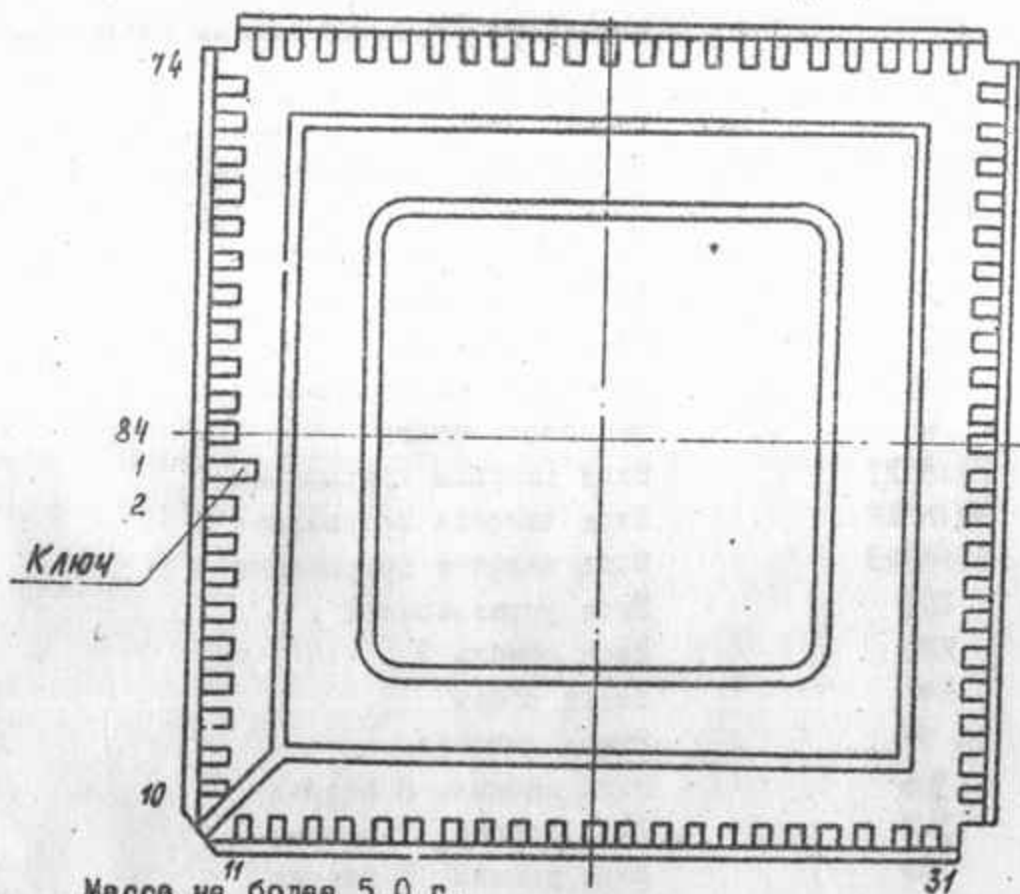


ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ

Номера выводов	Условное обозначение	Функциональное назначение выводов
1	INS8	Вход/выход микроинструкции, 8 разряд
2	-	Не использовать
3	INS7	Вход/выход микроинструкции, 7 разряд
4	INS6	Вход/выход микроинструкции, 6 разряд
5	INS5	Вход/выход микроинструкции, 5 разряд

Номера выводов	Условное обозначение	Функциональное назначение выводов
6	-	Не использовать
7	INS4	Вход/выход микроинструкции, 4 разряд
8	INS3	Вход/выход микроинструкции, 3 разряд
9	INS2	Вход/выход микроинструкции, 2 разряд
10	0V	Вывод общий
11	+5V	Вывод питания
12	INS1	Вход/выход микроинструкции, 1 разряд
13	INS0	Вход/выход микроинструкции, 0 разряд
14	AI00	Выход ввода/вывода адреса, 0 разряд
15	AI01	Выход ввода/вывода адреса, 1 разряд
16	AI02	Выход ввода/вывода адреса, 2 разряд
17	-	Не использовать
18	AI03	Выход ввода/вывода адреса, 3 разряд
19	DCINS	Вход/выход дешифрации инструкций
20	ERI	Вход ошибки 1
21	SEP	Вход выбора процессора
22	INRB	Вход прерывания шины
23	HLT	Вход "останов"
24	RQ/NR0	Вход запроса прерывания 0
25	-	Не использовать
26	RQ/NR1	Вход запроса прерывания 1
27	RQ/NR2	Вход запроса прерывания 2
28	RQ/NR3	Вход запроса прерывания 3
29	COI	Вход управления 1
30	ER2	Вход ошибки 2
31	0V	Вывод общий
32	+5V	Вывод питания
33	D6	Вход данных, 6 разряд
34	D7	Вход данных, 7 разряд
35	D8	Вход данных, 8 разряд
36	D0	Вход данных, 0 разряд
37	D9	Вход данных, 9 разряд
38	-	Не использовать
39	D10	Вход данных, 10 разряд
40	D11	Вход данных, 11 разряд
41	D12	Вход данных, 12 разряд
42	D13	Вход данных, 13 разряд
43	D14	Вход данных, 14 разряд
44	D15	Вход данных, 15 разряд
45	D1	Вход данных, 1 разряд

Номера выводов	Условное обозначение	Функциональное назначение выводов
46	-	Не использовать
47	D 2	Вход данных, 2 разряд
48	D 3	Вход данных, 3 разряд
49	D 4	Вход данных, 4 разряд
50	D 5	Вход данных, 5 разряд
51	SEMO	Вход выбора памяти 0
52	+ 5V	Вывод питания
53	0V	Вывод общий
54	CI	Вход такта I
55	SEMI	Вход выбора памяти I
56	EIO	Вход разрешения ввода-вывода
57	DB	Вход запрета
58	SAM	Вход состояния памяти
59	-	Не использовать
60	COEX	Вход управления расширением
61	CO2	Вход управления 2
62	DRA	Вход готовности данных
63	ST	Вход "Пуск"
64	CHI	Вход контроля I
65	CH3	Вход контроля 3
66	SEMCO	Вход/выход выбора управляющей памяти
67	-	Не использовать
68	INS 21	Вход/выход микроинструкции, 21 разряд
69	INS 20	Вход/выход микроинструкции, 20 разряд
70	INS 19	Вход/выход микроинструкции, 19 разряд
71	INS 18	Вход/выход микроинструкции, 18 разряд
72	INS 17	Вход/выход микроинструкции, 17 разряд
73	+ 5V	Вывод питания
74	0V	Вывод общий
75	INS 16	Вход/выход микроинструкции, 16 разряд
76	INS 15	Вход/выход микроинструкции, 15 разряд
77	INS 14	Вход/выход микроинструкции, 14 разряд
78	-	Не использовать
79	INS 13	Вход/выход микроинструкции, 13 разряд
80	INS 12	Вход/выход микроинструкции, 12 разряд
81	INS 11	Вход/выход микроинструкции, 11 разряд
82	-	Не использовать
83	INS 10	Вход/выход микроинструкции, 10 разряд
84	INS 9	Вход/выход микроинструкции, 9 разряд

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при $t = (+25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра	Н о р м а		Примечание
	не менее	не более	
1. Выходное напряжение высокого уровня, В при $I_{\text{он}} = (-2,0 \pm 0,1) \text{ мА}$ $U_{\text{св}} = (5,0 - 0,25) \text{ В}$	4,35		Измерение на выводах микросхемы I, 3...5, 7...9, 12, 13, 68...72, 75...77, 79...81, 83, 84
2. Выходное напряжение низкого уровня, В при $I_{\text{оЛ}} = (2,0 \pm 0,1) \text{ мА}$ $U_{\text{св}} = (5,0 - 0,25) \text{ В}$		0,4	Измерение на выводах микросхемы I, 3...5, 7...9, 12...16, 18, 19, 68...72, 75...77, 79...81, 83, 84
3. Выходное напряжение высокого уровня, В при $I_{\text{он}} = (-2,0 \pm 0,1) \text{ мА}$ $U_{\text{св}} = (5,0 - 0,25) \text{ В}$	2,4		Измерение на выводах микросхемы, 14...16, 18, 19
4. Ток потребления, мА $U_{\text{св}} = (5,0 \pm 0,25) \text{ В}$		30	Для объединенных выводов микросхемы, II, 32, 52, 73
5. Период следования импульсов тактового сигнала, нс $U_{\text{св}} = (5,0 - 0,25) \text{ В}$	65		

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 ШТ.

золото 47,9513г
серебро 41,200г
Цветных металлов не содержится

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы типа КН 1В31 ВУ1 соответствует техническим условиям
ОК0.348.966-02 ТУ

ОТК490

2.2. НОЯ. 1991

ШТАМП ОТК

ШТАМП "ПЕРЕПРОВЕРКА ПРОИЗВЕДЕНА"

ШТАМП ОТК

7К 134